

T S4/7

4/7/1

DIALOG(R) File 351:Derwent WPI
 (c) 2002 Thomson Derwent. All rts. reserv.

014367313 **Image available**

WPI Acc No: 2002-188015/200224

Projection lens e.g. for photolithography during semiconductor
 manufacture, has double aspherical lens spaced from image plane by more
 than maximum lens diameter

Patent Assignee: ZEISS CARL (ZEIS); ZEISS STIFTUNG T/A CARL ZEISS (ZEIS)

Inventor: SCHUSTER K; SINGER W; BEIERL H; SHAFER D R

Number of Countries: 029 Number of Patents: 005

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
WO 200150171	A1	20010712	WO 2000EP13148	A	20001222	200224 B
DE 10002626	A1	20010726	DE 1002626	A	20000122	200224
DE 10119861	A1	20011108	DE 1019861	A	20010424	200224
EP 1164399	A2	20011219	EP 2001110646	A	20010502	200224
US 20020008861	A1	20020124	US 2001847658	A	20010502	200224

Priority Applications (No Type Date): DE 1021739 A 20000504; US 99173523 P
 19991229; DE 1002626 A 20000122

Patent Details:

Patent No	Kind	Lat Pg	Main IPC	Filing Notes
-----------	------	--------	----------	--------------

WO 200150171 A1 G 67 G02B-013/14

Designated States (National): JP KR US

Designated States (Regional): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU
 MC NL PT SE TR

DE 10002626 A1 G02B-017/08

DE 10119861 A1 G02B-015/00

EP 1164399 A2 G G02B-013/14

Designated States (Regional): AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT
 LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI TR

US 20020008861 A1 G03B-027/42

Abstract (Basic): WO 200150171 A1

NOVELTY - The projection lens has at least 5 different lens groups (G1-G5), each provided with a number of lens surfaces, at least 2 of the lens surfaces lying adjacent one another for providing a double aspherical lens (21), which is positioned at a minimum distance from the image plane (0') of greater than the maximum lens diameter.

USE - The lens can be used as a refractive projection objective for photolithography, e.g. for semiconductor manufacture.

ADVANTAGE - The lens provides a high quality projection image.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows a schematic representation of a projection objective with a numerical aperture of 0.8.

Double aspherical lens (21)

Lens groups (G1-G5)

Image plane (0')

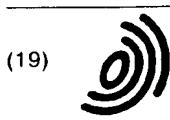
pp; 67 DwgNo 2/9

Derwent Class: P81; P84; U11

International Patent Class (Main): G02B-013/14; G02B-015/00; G02B-017/08;
 G03B-027/42

International Patent Class (Additional): G02B-001/02; G02B-013/18;
 G02B-021/04; G03F-007/20

?



(19)

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 1 164 399 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
19.12.2001 Patentblatt 2001/51

(51) Int Cl. 7: G02B 13/14, G03F 7/20

(21) Anmeldenummer: 01110646.5

(22) Anmeldetag: 02.05.2001

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder:

- Singer, Wolfgang, Dr.
73431 Aalen (DE)
- Schuster, Karl-Heinz
89551 Koenigsbronn (DE)

(30) Priorität: 04.05.2000 DE 10021739
24.04.2001 DE 10119861

(74) Vertreter: Lorenz, Werner, Dr.-Ing.
Lorenz & Kollegen Patent- und
Rechtsanwaltskanzlei Alte Ulmer Strasse 2-4
89522 Heidenheim (DE)

(71) Anmelder: Carl Zeiss
89518 Heidenheim (Brenz) (DE)

(54) Projektionsobjektiv, insbesondere für die Mikrolithographie

(57) Ein Projektionsobjektiv (3), insbesondere für die Mikrolithographie, ist mit einer Objektebene (7), mit einer Bildebene (9), mit einer Linsenanordnung (4) und mit wenigstens einem mit Gas gefüllten oder mit Gas durchströmten Gasraum versehen. Der Gasraum ist als annähernd planparalleler Manipulationsraum (13) ausgebildet. Durch Druckänderungen und/oder Gaszusammensetzungsänderungen im Manipulationsraum (13) ist die Brechzahl veränderbar.

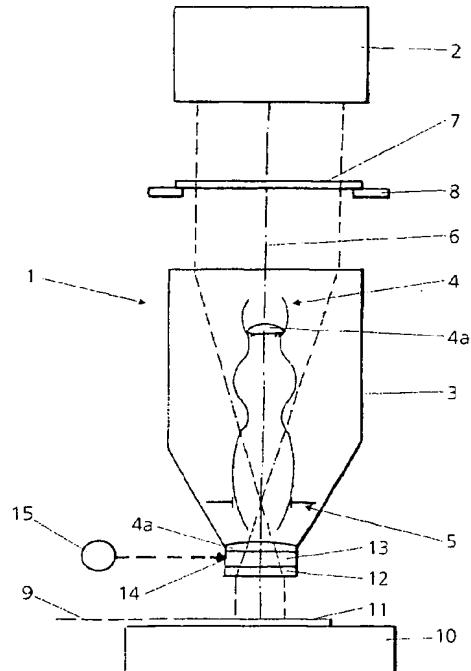


Fig. 1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Projektionsobjektiv, insbesondere für die Mikrolithographie mit einer Linsenanordnung, nach der im Oberbegriff von Anspruch 1 näher definierten Art. Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung mikrostrukturierter Bauteile mit einer Projektionsbelichtungsanlage.

[0002] Aus der US 4,871,237 ist es bereits bekannt, in Abhängigkeit vom barometrischen Druck ein Objektiv abzustimmen und zwar über den Brechungsindex eines Füllgases in Linsenzwischenräumen. Durch eine geeignete Kombination von Zwischenräumen können z.B. sphärische Aberration, Koma und andere Fehler korrigiert werden. Nachteilig bei diesem Objektiv ist jedoch, daß mit der Beseitigung eines Fehlers, z.B. einer sphärischen Aberration, andere Fehler initiiert werden.

[0003] Aus der US 4,676,614 ist eine Projektionsbelichtungsanlage bekannt, die einen Gasraum umfaßt, der mit Druck beaufschlagbar ist. Durch eine gezielte Druckbeaufschlagung können die durch eine Druckänderung des atmosphärischen Drucks bedingten Bildfehler kompensiert werden.

[0004] Aus der US 5,559,584 ist es bekannt, bei einer Projektionsbelichtungsanlage zur Herstellung mikrostrukturierter Bauteile in den Zwischenraum zwischen einem Wafer und/oder einem Reticle und dem Projektionsobjektiv Schutzgas einzubringen.

[0005] Durch Umwelteinflüsse, wie z.B. Luftdruckänderung, entsteht bei Lithographieobjektiven unter anderem sphärische Aberration als Bildfehler. Andere Einflußgrößen sind lens-heating und compaction, welche ebenfalls zu sphärischer Aberration führen. Insbesondere bei hoher numerischer Apertur wird der Betrag der sphärischen Aberration sehr groß und bei den geforderten Genauigkeiten nicht mehr tolerierbar.

[0006] Bekannt ist es, neben der eingangs erwähnten US 4,871,237, bei DUV-Objektiven durch Wellenlängenänderungen barometrische und wetterbedingte Druckänderungen zu kompensieren. Bei 365 nm, 193 nm-Objektiven funktioniert dieses Verfahren jedoch nicht mehr und zwar aufgrund der chromatischen Korrektion der Objektive, d.h. bei Verwendung verschiedener Materialien führt die unterschiedliche Variation der Brechzahlen mit der Wellenlänge zu nicht tolerierbaren Bildfehlern.

[0007] Bekannt ist es auch aus der Praxis, zur Kompensation von Restfehlern, verursacht durch Umwelteinflüsse, z-Manipulatoren einzusetzen, das heißt z.B. in Richtung der optischen Achse aktiv verschiebbare Linsenelemente. Nachteilig bei diesem Verfahren ist jedoch, neben dem hierfür erforderlichen großen Aufwand, daß man damit ebenfalls wieder andere Fehler einführt.

[0008] Allen bekannten Verfahren ist deshalb gemeinsam, daß sie mehr oder weniger gut sphärische Aberration kompensieren, jedoch gleichzeitig wieder andere Fehler einführen oder nur unvollständig wirken. Ein erschwerender Faktor kommt hinzu, wenn die verwendeten optischen Materialien, insbesondere Linsen, aus unterschiedlichen Materialien, wie z.B. Kalziumfluorid und Quarzglas bestehen, weil dadurch unterschiedlich varierende Brechzahlen über der Wellenlänge auftreten, falls über die Wellenlänge manipuliert werden soll.

[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Projektionsobjektiv zu schaffen, das mit weniger Linsen eine sehr gute Qualität, insbesondere auch bei hoher Apertur, aufweist, wobei gleichzeitig auch Korrekturmöglichkeiten gegeben sein sollen. Insbesondere soll eine Korrektur des konstanten Feldanteiles einer sphärischen Aberration ermöglicht werden. Ebenso liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung mikrostrukturierter Bauteile zu schaffen, bei dem sphärische Aberration soweit wie möglich korrigiert werden kann.

[0010] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die im kennzeichnenden Teil von Anspruch 1 genannten Merkmale gelöst.

[0011] Eine weitere Lösung der Aufgabe ist in Anspruch 8 aufgezeigt.

[0012] In Anspruch 20 ist ein Verfahren zur Herstellung mikrostrukturierter Bauteile beschrieben.

[0013] Bei von ebenen Flächen begrenzten parallelen Räumen und Elementen entsteht in gut telezentrischen Systemen bei Änderung einer Brechzahl, insbesondere hinter und vor einer Abschlußplatte, nur sphärische Aberration. Diese Tatsache wurde nun bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung ausgenutzt. Druckänderungen in einem derartigen Raum ändern die sphärische Aberration. Gleches gilt auch für die Änderung einer Gaszusammensetzung. Dieser Sachverhalt wird erfindungsgemäß nunmehr für eine aktive Manipulation für sphärische Aberration genutzt.

[0014] Legt man dabei den Manipulationsraum zwischen einer letzten Abschlußplatte vor dem zu beleuchtenden Substrat und der der Abschlußplatte benachbart liegenden optischen Linse, welche in diesem Falle auf der der Abschlußplatte zugewandten Seite sein muß, so lassen sich durch Änderungen des Druckes in dem Manipulationsraum und/oder der Gaszusammensetzung bzw. dessen aktiven Steuerung die auf diese Weise "künstlich" erzeugte sphärische Aberration eine Aberration des Objektives vermeiden bzw. entsprechend korrigieren bzw. kompensieren.

[0015] Gleches gilt auch, wenn man den Manipulationsraum zwischen der Abschlußplatte und der Bildebene einrichtet.

[0016] In vorteilhafter Weise wird man vorab ein Vorhalt bzw. Offset der Brechzahl über eine bestimmte Ausgangsgasmischung einstellen, um Brechzahländerungen in beide Richtungen d.h. Erhöhungen und Erniedrigungen, zu ermöglichen.

[0017] Mit anderen Worten: Ändert man die Brechzahl in dem Manipulationsraum, so führt man fast ausschließlich sphärische Aberration (konstanter Feldverlauf) ein. Die Änderung der Brechzahl wird erfindungsgemäß durch die gewählte Zusammensetzung des in den Manipulationsraum einzubringenden Gases bzw. Gasgemisches und/oder des Druckes erreicht. Um durch die Druckzugabe keine neuen Fehler einzubringen, z.B. durch Durchbiegungen der den Manipulationsraum begrenzenden Flächen, müssen die den Manipulationsraum abschließenden Elemente den angegebenen Durchmesser/Dickenverhältnissen entsprechen.

[0018] In einer sehr vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, daß neben dem Manipulationsraum zusätzlich ein weiterer manipulierbaren Gaszwischenraum vorgesehen wird. Den weiteren Gaszwischenraum kann man mit einer leichten Brechkraft versehen, d.h. daß wenigstens eine den Gaszwischenraum in z-Richtung begrenzende Fläche mit einer leichten Wölbung versehen ist. Bringt man in diesen Gaszwischenraum ebenfalls ein Gas bzw. ein Gasgemisch ein, dann kann man durch eine Gasmischungsänderung oder auch über eine Druckänderung die Brechkraft verändern. Auf diese Weise läßt sich eine evtl. entstandene Bildfeldwölbung auf dem zu belichtenden Substrat ändern. Für eine möglichst genaue Abbildung auf dem ebenen Substrat soll nämlich keine Bildfeldwölbung vorhanden sein. Ändert sich etwa durch Linsenerwärmung die Bildfeldwölbung, läßt sich diese nachteilige Bildfeldwölbung erfindungsgemäß nunmehr durch den weiteren manipulierbaren Gaszwischenraum beseitigen. Dies gilt insbesondere dann, wenn dieser möglichst nahe an dem zu belichtenden Substrat liegt. Gleichzeitig wird auf diese Weise vermieden, daß man damit wieder andere Fehler erzeugt.

[0019] Durch die erfindungsgemäßige Ausbildung eines optischen Elementes nach Anspruch 8, das mehr oder weniger eine wenigstens annähernd planparallele Form besitzt und durch die angegebene Dicke, welche im Vergleich zu bekannten optischen Elementen, wie z.B. einer Abschlußplatte eines Objektives, größer ist, ergibt sich der Vorteil, daß z.B. Bildfehler die durch das dicke Element über das Feld entstehen, durch die Planparallelität des optischen Elementes nur unwesentlich verändert werden. Dieses Element reagiert über das Bildfeld immer gleich, weil das Objektiv in diesem Bereich telezentrisch ist. Da dieses optische Element keine oder zumindest keine nennenswerte Krümmungsradien besitzt, können keine Radien auf irgendeine Weise einen ungünstigen Einfluß ausüben, insbesondere, z.B. wenn das Feld zunimmt oder die Apertur zunimmt. Mit anderen Worten: Das optische Element mit den erfindungsgemäßigen Maßangaben und Dimensionen führt zu keinen Veränderungen mehr, was bedeutet, daß bestimmte Aberrationen in dem hoch geöffneten Objektiv im Prinzip besser vorhersehbar sind und auf diese Weise weiter vorne bzw. bereits im Eingangsbereich korrigiert werden können.

[0020] Wenn in einer sehr vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen ist, daß das optische Element und ein weiteres optisches Element der sechsten optischen Gruppe einen Gasraum einschließen, wobei für den Krümmungsradius R3 der Fläche des zweiten optischen Elementes, die der ersten Linse zugewandt ist, gilt: $R3 > 3000$ mm, vorzugsweise > 5000 mm, so erhält man auf diese Weise einen quasi planparallelen Gasraum, welcher in einer sehr vorteilhaften Weise der Erfindung als Manipulationsraum verwendet werden kann.

[0021] Eine weitere, sehr vorteilhafte und nicht naheliegende Weiterbildung der Erfindung in der Verwendung eines optischen Elementes in der sechsten Linsengruppe mit den angegebenen Krümmungsradien und Durchmesser/Dickenverhältnissen besteht darin, daß man in der ersten Linsengruppe eine Linse mit einer asphärischen Fläche vorsieht.

[0022] Mit der erfindungsgemäßigen asphärischen Fläche lassen sich bereits im Eingangsbereich des Objektives Korrekturen erreichen, wie z.B. die Beseitigung von Schalenfehler und Bildfeldwölbung. Dies gilt insbesondere bei sehr hoch geöffneten Objektiven und insbesondere dann, wenn man die Asphäre möglichst nahe am Eingang des Objektives anbringt, zumindest vor dem ersten Bauch, am besten bereits an der ersten gekrümmten Fläche.

[0023] Erfindungsgemäß ist es damit möglich, Aperturen von mindestens 0,75, vorzugsweise 0,85 zu erreichen, wobei man trotzdem noch ein sehr dickes optisches Element ausgangsseitig, z.B. eine dicke Abschlußplatte, anbringen kann. Da ein optisches Element gemäß Anspruch 1 keine Veränderungen mehr einführt, ist man z.B. in der Lage, die Aberration vorherzusagen, d.h. wie sie sich im Objektiv entwickelt. Mit der erfindungsgemäßigen Asphäre läßt sich die Aberration dementsprechend beeinflussen bzw. korrigieren. Dies kann dabei in einer vorteilhaften Weise in einem Bereich erfolgen, in dem die Apertur noch relativ klein ist.

[0024] Wenn die Asphäre vor dem ersten Lichtbauch angeordnet ist, ist eine Trennung des Lichtbüschels noch besser durchzuführen.

[0025] Die sechste optische Gruppe kann erfindungsgemäß nur aus Planparallelplatten bestehen. Selbstverständlich ist es auch möglich, ein oder zwei Linsen in der sechsten optischen Gruppe vorzusehen, wobei dann zumindest eine Linse eine wenigstens annähernd ebene Fläche aufweisen sollte, die zu einer weiteren planparallelen Fläche, z.B. einer Abschlußplatte, benachbart liegt, damit dazwischen dann der erfindungsgemäßige Manipulationsraum gebildet werden kann.

[0026] Von Vorteil ist auch, wenn Linsen in der sechsten Linsengruppe und gegebenenfalls auch in der fünften Linsengruppe, d.h. die Linsen, die bei der Mikrolithographie einem Wafer am nächsten liegen, nur positive Brechkraft besitzen. Vorzugsweise wird man an dieser Stelle wenigstens zwei oder drei entsprechende Linsen anordnen.

[0027] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den übrigen Unteransprüchen und aus den nachfolgend anhand der Zeichnung prinzipiell beschriebenen Ausführungsbeispielen.

EP 1 164 399 A2

[0028] In den dargestellten Ausführungsbeispielen sind zwar nur rein refraktive Objektive gezeigt, dennoch ist diese Erfindung nicht beschränkt auf refraktive Systeme, sondern auch auf katadioptrischen Systemen zu lesen.

[0029] Es zeigt:

5 Figur 1 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Projektionsbelichtungsanlage mit einem Projektionsobjektiv,

10 Figur 2 einen Schnitt durch den unteren Teil des Projektionsobjektives mit einer Abschlußplatte und einer daran angrenzenden Linse mit einem Manipulationsraum dazwischen in vergrößerter Darstellung,

15 Figur 3 einen Manipulationsraum, der durch eine zweigeteilte Abschlußplatte gebildet ist, in vergrößerter Darstellung,

Figur 4 ein Ausführungsbeispiel mit einem Manipulationsraum und einem weiteren Gaszwischenraum in vergrößerter Darstellung,

15 Figur 5 einen Linsenschnitt durch eine erste Linsenanordnung, und

Figur 6 einen Linsenschnitt durch eine zweite Linsenanordnung.

20 [0030] Der prinzipielle Aufbau einer Projektionsbelichtungsanlage 1 ist nachfolgend anhand der Figur 1 beschrieben. Die Projektionsbelichtungsanlage 1 weist eine Beleuchtungseinrichtung 2 und ein Projektionsobjektiv 3 auf. Das Projektionsobjektiv 3 umfaßt eine Linsenanordnung 4 mit einer Vielzahl von in der Figur 1 nicht näher dargestellten Linsen 4a und einer Aperturblende 5. Die Linsen 4a sind entlang einer optischen Achse 6 angeordnet. Zwischen der Beleuchtungseinrichtung 2 und dem Projektionsobjektiv 3 ist eine Maske bzw. Reticle 7 angeordnet, die mittels eines Maskenhalters 8 im Strahlengang gehalten wird. Die Maske 7 wird mittels des Projektionsobjektives 3 in einem deutlich verkleinerten Faktor auf einer Bildebene 9 abgebildet. Solche in der Mikrolithographie verwendete Masken 7 weisen eine Mikrometer- bzw. Nanometerstruktur auf, die mittels des Projektionsobjektives 3 bis zu einem Faktor von 10, insbesondere um den Faktor 4 verkleinert auf der Bildebene 13 abgebildet wird. Die noch auflösbarer minimalen Strukturen hängen von der Wellenlänge λ des für die Beleuchtung verwendeten Lichtes sowie von der Apertur der Aperturblende 5 ab, wobei die maximal erreichbare Auflösung der Projektionsbelichtungsanlage mit Abnehmen der Wellenlänge der Beleuchtungseinrichtung 2 und mit zunehmender Apertur des Projektionsobjektives 3 steigt.

[0031] In der Bildebene 9 ist ein durch einen Substrathalter 10 positioniertes Substrat bzw. ein Wafer 11 gehalten.

[0032] Den Abschluß des Projektionsobjektives 3 in Richtung des Wafers 11 bildet eine ebene Abschlußplatte 12. Auf Abstand zu der Abschlußplatte 12 befindet sich eine letzte Linse 4a der Linsenanordnung 4. Zwischen der Abschlußplatte 12 und der letzten Linse 4a wird auf diese Weise ein Manipulationsraum 13 geschaffen, der gegen die umgebenden Teile abgedichtet ist. Wie ersichtlich, ist die der Abschlußplatte 12 zugewandte Seite der letzten Linse 4a ebenfalls plan, womit eine Planparallelität für den Manipulationsraum 13 geschaffen wird. Selbstverständlich ist es nicht unbedingt erforderlich, daß die der Abschlußplatte 12 zugewandte Seite der letzten Linse 4a absolut planparallel ist. Bei entsprechend großen Linsenradien, z.B. mit Radien $R > 3000$ mm, vorzugsweise > 5000 mm, wird ebenfalls 40 quasi eine Planparallelität erreicht, durch die es möglich ist, die Erzeugung der sphärischen Aberration in dem Manipulationsraum 13 entsprechend zu beeinflussen.

[0033] Der Manipulationsraum 13 ist mit einem Druckanschluß 14 versehen, über den er mit einer nicht näher dargestellten Gasquelle 15 verbunden ist (siehe auch vergrößerte Darstellung in Figur 2).

[0034] Durch Änderung der Gaszusammensetzung, welche in den Manipulationsraum 13 von der Gasquelle 15 aus 45 eingebracht wird und/oder eine Druckänderung, werden Brechzahländerungen in das Projektionsobjektiv 3 eingebracht und zwar kurz vor dem Austritt, womit keine weiteren Abbildungsfehler mehr eingebracht werden können. Durch die Änderung der Brechzahl wird eine sphärische Aberration geschaffen, die man dazu verwendet, eine in dem Projektionsobjektiv 3 aufgetretene sphärische Aberration zu kompensieren oder auch in eine gewünschte Richtung zu manipulieren.

[0035] Anstelle eines Manipulationsraumes zwischen der Abschlußplatte 12 und der daran angrenzenden letzten 50 Linse 4a kann ein planparallel er Manipulationsraum auch durch eine Zerteilung der Abschlußplatte 12 erreicht werden. In diesem Falle sind die beiden Abschlußplattenteile 12a und 12b auf Abstand voneinander angeordnet und bilden zwischen ihren planparallel Flächen den Manipulationsraum 13. Selbstverständlich ist es in diesem Falle erforderlich, die beiden Abschlußplattenteile mit einer entsprechenden Dicke auszubilden, damit es zu keinen Verbiegungen kommt (siehe Figur 3). Aus diesem Grunde sollte ein Verhältnis von Dicke d_1 zu Durchmesser D_1 von 1 : 5 vorzugsweise 1 : 3 eingehalten sein.

[0036] Die Figur 4 zeigt eine Ausführungsform mit einem zusätzlichen Gaszwischenraum 16 neben dem Manipulationsraum 13. Um einen möglichst hohen Wirkungsgrad für den Manipulator zu erzielen, wird der Gaszwischenraum

EP 1 164 399 A2

16 möglichst nahe an dem Wafer 11 angeordnet, so daß in diesem Falle der Manipulationsraum 13 entsprechend weiter zurückliegt. Der Gaszwischenraum 16 wird dabei ebenfalls durch eine Zweiteiligkeit der Abschlußplatte 12 in die beiden Plattenteile 12a und 12b geschaffen. Der Zwischenraum 16 ist ebenfalls über einen eigenen Druckanschluß 14' mit einer Gasquelle 15' verbunden. Im Unterschied zu dem Manipulationsraum 13 ist jedoch wenigstens eine der beiden quer zur z-Richtung liegenden Fläche mit einer leichten Krümmung 17 versehen.

5 [0037] Wenn man weiß, daß das Projektionsobjektiv an einem bestimmten Ort, d.h. bei einer bestimmten barometrischen Höhe eingesetzt wird, so empfiehlt sich folgendes Vorgehen:

[0038] Einsatzort z.B. auf 1700 Meter Höhe mit entsprechend reduziertem oder erhöhtem Luftdruck gegenüber dem Objektivhersteller. Beim Abstimmen des Objektives beim Hersteller, der sich z.B. auf Meereshöhe oder einer anderen niedrigeren Höhe als der des Einsatzortes befindet, wird der Manipulationsraum mit einer gezielt eingestellten Gasmischung versehen, deren Brechzahlen um die um die durch Druckdifferenz verursachte Brechzahl höher ist, als der am Einsatzort. Auf diese Weise kann später am Einsatzort der Manipulationsraum einfach mit einem üblichen Füllgas, z.B. synthetische Luft, Sauerstoff, Stickstoff oder Helium, mit dem durchschnittlichen Druck am Aufstellort gefüllt werden, was damit ein exakt abgestimmtes Objektiv ergibt. Natürliche wetterbedingte Luftdruckänderungen gleicht man nun durch kleine Druckänderungen im Manipulationsraum aus. Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, daß der Kunde nur übliches Füllgas in den Manipulationsraum einfüllen muß und nur geringe Druckdifferenzen eingestellt werden müssen.

10 [0039] Möchte man sich nicht festlegen, wo der spätere Einsatzort liegt, so stimmt man mit dem üblichen Füllgas ab. Allerdings muß dann später eine höher brechende Gasmischung am Einsatzort benutzt werden, wenn die barometrische Höhe steigt. Luftdruckänderungen durch das Wetter werden dabei ebenfalls jedoch durch kleine Änderungen des Gasdruckes im Manipulationsraum ausgeglichen.

15 [0040] In den Figuren 5 und 6 sind beispielsweise Linsenschnitte durch Linsenanordnungen dargestellt.

20 [0041] Die Ausführungsbeispiele beziehen sich auf ein Projektionsobjektiv 3 mit einer Linsenanordnung 4, die in sechs optischen Gruppen (LG1 bis LG 6) unterteilt ist. Die erste, dritte und fünfte Linsengruppe weisen positive Brechkraft auf und die zweite und vierte Linsengruppe weisen jeweils negative Brechkraft auf. Im folgenden wird die Unterteilung des Linsensystems in Linsengruppen näher ausgeführt, wobei die Ausbreitungsrichtung der Strahlen zugrunde gelegt worden ist.

25 [0042] Die erste Linsengruppe LG 1 ist positiv und endet mit einer Linse positiver Brechkraft. Durch die erste Linsengruppe wird ein Bauch gebildet, wobei es unerheblich ist, wenn in dem Bauch auch Negativlinsen angeordnet sind.

30 [0043] Die zweite Linsengruppe LG 2 ist in ihrer Gesamtbrechkraft negativ. Diese zweite Linsengruppe LG 2 weist als erste Linse eine bildseitig mit einer konkaven Linsenoberfläche ausgebildete Linse auf. Diese zweite Linsengruppe LG 2 beschreibt im wesentlichen eine Taille. Auch hier ist es nicht maßgeblich, wenn einzelne positive Linsen in der zweiten Linsengruppe LG 2 enthalten sind, solange die Taille erhalten bleibt.

35 [0044] Die dritte Linsengruppe LG 3 beginnt mit einer Linse positiver Brechkraft, die bildseitig eine konvexe Linsenoberfläche aufweist und ein Meniskus sein kann. Ist als erste Linse eine dicke Meniskenlinse vorgesehen, so kann innerhalb der Linse die Trennung der Linsengruppen gedacht sein.

40 [0045] Die vierte Linsengruppe LG 4 ist von negativer Brechkraft. Diese vierte Linsengruppe beginnt mit einer Linse negativer Brechkraft, auf die mehrere Linsen mit negativer Brechkraft folgen. Durch diese Linsengruppe wird eine Taille gebildet. Es ist unerheblich, ob innerhalb dieser Linsengruppe auch Linsen positiver Brechkraft angeordnet sind, so lange diese den Strahlenverlauf nur auf einer kurzen Distanz beeinflußt und somit die Taillenform der vierten Linsengruppe erhalten bleibt.

45 [0046] Die fünfte Linsengruppe LG 5 ist in ihrer Gesamtheit von positiver Brechkraft. Die erste Linse dieser fünften Linsengruppe LG 5 weist bildseitig eine konvexe Linsenfläche auf. Durch die fünfte Linsengruppe LG 5 wird ein Bauch gebildet.

50 [0047] Nach der Linse mit dem maximalen Durchmesser (der Bauch) folgen noch mindestens zwei positive Linsen in der fünften Linsengruppe LG 5, wobei auch noch negative Linsen zugelassen sind. Die letzte Linse der fünften Linsengruppe LG 5 weist bildseitig eine konkave Linsenfläche auf.

[0048] Die sechste optische Gruppe LG 6 umfaßt die optischen Elemente nach der fünften Linsengruppe bis zur Bildebene.

55 [0049] Solche Projektionsobjektive werden insbesondere in der Mikrolithographie eingesetzt. Sie sind z.B. aus den DE 199 42 281 A, DE 198 55 108 A, DE 198 55 157 A und DE 198 55 158 A der Anmelderin und dem dort zitierten Stand der Technik bekannt. Diese Schriften sollen auch Inhalt dieser Anmeldung sein.

[0050] Herkömmlich weisen diese Objektive in der ersten und sechsten Gruppe Lufträume auf, die in der Regel bis auf den Luftraum zwischen Objekt ebene und erster optischer Fläche und den Luftraum zwischen letzter optischer Fläche und Bildebene zumindestens auf einer Seite durch eine gekrümmte Fläche begrenzt werden.

60 [0051] Die Figuren 5 und 6 sind sich in ihrem grundsätzlichen Aufbau ähnlich. Bei der Figur 5 ist der Manipulationsraum 13 zwischen der Abschlußplatte 12 und der Linse 4a gebildet entsprechend der Prinzipdarstellung in der Figur 4.

[0052] In der Figur 6 ist die Abschlußplatte zweiteilig ausgebildet, nämlich mit den Teilen 12a und 12b und der Ma-

EP 1 164 399 A2

nipulationsraum 13 befindet sich dazwischen, wie es auch aus der Prinzipdarstellung der Figur 3 ersichtlich ist. Eine Linse ist bei diesem Ausführungsbeispiel in der sechsten Gruppe nicht mehr vorgesehen.

[0053] In der ersten Linsengruppe LG 1 kann eine Linse 4c mit einer asphärischen Fläche vorgesehen sein, wobei die asphärische Fläche in Lichtrichtung vor dem ersten Bauch angeordnet sein kann. Vorzugsweise weist das Projektionsobjektiv 3 bildseitig eine numerische Apertur von mindestens 0,75, vorzugsweise 0,85, auf.

[0054] Als Lichtquelle kann man für die Mikrolithographie einen Laser verwenden, der eine Strahlung von kürzerer Wellenlänge als 250 nm abgibt.

[0055] Bei der Herstellung mikrostrukturierter Bauteile, bei der das mit einer lichtempfindlichen Schicht versehene Substrat 11 mittels der Maske 7 und der Projektionsbelichtungsanlage 1 durch ultraviolette Laserlicht belichtet wird, wird gegebenenfalls nach dem Entwickeln der lichtempfindlichen Schicht entsprechend ein auf der Maske 11 enthaltenes Muster strukturiert.

[0056] Figur 5 zeigt die Realisierbarkeit eines Lithographieobjektives bezüglich eines manipulierbaren planparallelen Luftraumes im ausgehenden Teil zum Wafer hin. Bisher war es nicht bekannt, einen derart dicken planparallelen Luft-
raum und eine dicke planparallele Platte in einem derart hoch geöffneten Objektiv bereit zu stellen.

[0057] Aberrationen die bisher im absteigenden Bereich des dritten Bauches korrigiert wurden, sollten nun vorwiegend im Bereich erster Bauch, erste Taille, zweiter Bauch korrigiert werden. Es wurde gefunden, daß dies sogar deutlich korrektive Vorteile aufweist, wenn bei höchster Apertur die Optik mit einer dicken Planparallelplatte abschließt. Deshalb wurde dieses Verfahren weiter getrieben, in dem die dicke Platte deutlich an Dicke gewinnt. Das Verhältnis Dicke zu Durchmesser sollte dabei mindestens 1 : 5 betragen. (Beide Platten wirken optisch wie eine einzige dicke Platte).

[0058] Figur 6 zeigt eine Ausführung mit einer besonders dicken Planparallelplatte. Sie stellt die Lösung für gleich drei weitere Probleme dar.

[0059] Bei der Korrektion von hochgeöffneten Lithographieobjektiven bekommt man sehr hohe $\sin \theta$ in Belastungen im Bereich vor dem Wafer. Die Krümmungen, welche nun einzelne Linsen annehmen können, als Sphäre, verursachen nun Aberrationen mit deutlich unterschiedlicher Wirkung zwischen Bildfeldrand und Bildfeldmitte (auch über der Apertur). Vielfach sind dies Wirkungen, die man im Objektiv sucht und besonders bereitstellt. Hier, bei großen Feldern und höchsten Aperturen, können sie aber unbeherrschbar werden oder doch wenigstens die Korrektion stören. Die Lösung stellt nun tatsächlich eine sehr dicke planparallele Platte dar, die den gewünschten Beitrag an sphärischer Überkorrektion liefert, bezüglich des Bildfeldes aber nun völlig isoplanatisch wirkt. Damit lassen sich nun Apertur und Bildfeld sehr groß machen.

[0060] Neben dem korrekten Vorteil kann man die Zahl der Linsen, durch das Zusammenfassen zu einer dicken Planparallelplatte verringern. Damit nimmt die Anzahl der Linsenoberflächen mit sehr hoher Winkelbelastung, wie sie vor dem Wafer üblich ist, ab. Die Vorteile sind geringere Kosten und weniger Reflexionsverluste und damit höhere Transmission. Dies ist insbesondere für Wellenlängen von 157 nm und 193 nm bedeutsam. Ein weiterer Aspekt ist, daß die dicke Platte die Zahl der Fassungsteile wesentlich in einem Bereich vereinfachen kann, in dem bekannterma-

ßen wenig Platz vorhanden ist. Vor dem Wafer sitzen die unterschiedlichsten Bilderkennungssensoren, die sich dicht an die eigentliche Lithographieoptik anschmiegen. Die dicke Planparallelplatte schafft auch hier die Möglichkeit, innerhalb eines bestimmten konstruktiven Raumes mehr Apertur und/oder mehr Feld unterzubringen. Dies ist auch unter dem Aspekt zu sehen, daß man etwa die gleiche Sensorik dann eine weitere Generation länger benutzen kann.

[0061] Eine dicke Platte oder dicke Platten vor dem Wafer sind also die erforderliche Lösung für

- Druckmanipulator vor Wafer im Objektiv
- Verbesserte Korrektionsmöglichkeit bei höchster Apertur und großem Feld
- Mehr Apertur und Feld bei gegebenem konstruktivem Platz
- Weniger hochbelastete Flächen, mehr Transmission

[0062] Beim Ausführungsbeispiel nach Figur 5 übernimmt eine Asphäre auf der ersten gekrümmten Fläche, Aufgaben die viele Linsen dicht vor dem Wafer teilweise mit übernommen haben. Der Vorteil hier ist nun aber die äußerst geringe Winkelbelastung auf der ersten gekrümmten Fläche. Zugleich läßt sich durch die gute Büscheltrennung ein ganz spezifischer Effekt bezüglich der Wirkung zwischen Bildmitte, Bildfeldzone und Bildfeldrand einstellen.

[0063] Grundsätzlich ist es auch möglich einen planparallelen Manipulationsraum auch zwischen einer letzten Abschlußplatte eines Projektionsobjektives und eines Wafers in der Mikrolithographie vorzusehen, in welchem durch Druckänderungen und/oder Gaszusammensetzungsänderungen die Brechzahl veränderbar ist. Für diesen Zweck ist der Zwischenraum zwischen der Abschlußplatte und dem Wafer entsprechend mit Spülgas entsprechender Zusammensetzung und einem entsprechenden Druck zu bespülen. Hierzu ist es im allgemeinen auch erforderlich, das gesamte Projektionsobjektiv "einzukapseln".

[0064] Nachfolgend ist beispielsweise jeweils die Designanordnung für die in den Figuren 5 und 6 dargestellten Linsenanordnungen angegeben. Selbstverständlich sind die anhand dieser Ausführungsbeispiele konkretisierten Merkmale und deren Kombinationen miteinander kombinierbar.

EP 1 164 399 A2

[0065] Beispiel nach der Figur 5:

Arbeitswellenlänge 1 = 193,3nm

Bildfeld-Durchmesser = 24,6mm

5 Bildseitige numerische Apertur NA = 0,85
 Abbildungsmaßstab β = -0,25
 Brechzahl $n(\text{SiO}_2)$ = 1,5603
 Brechzahl $n(\text{CAF}_2)$ = 1,5014

10

	Fläche	Radius	Asphäre	Dicke	Material	Durchm.
	OB			32,000	LUFT	
15	1	∞		6,329	SiO_2	110,8
	2	∞		1,383	HE	112,5
20	3	- 1393,131	A	6,329	SiO_2	112,8
	4	153,737		14,539	HE	118,0
25	5	191,890		23,775	SiO_2	135,0
	6	-359,189		0,678	HE	136,5
	7	-827,276		7,196	SiO_2	137,7
30	8	-475,714		0,678	HE	138,8
	9	296,346		18,036	SiO_2	141,7
	10	-561,014		0,678	HE	141,4
35	11	183,662		19,090	SiO_2	137,2
	12	- 16545,56 0	A	0,694	HE	135,1
40	13	326,464		6,329	SiO_2	129,2
	14	106,348		27,957	HE	118,2
	15	-235,452		6,329	SiO_2	117,5
45	16	304,109		15,255	HE	118,0
	17	-232,751		6,329	SiO_2	118,5
	18	174,842		33,179	HE	127,9
	19	-135,497		10,857	SiO_2	132,8
50	20	-567,373	A	11,495	HE	160,3
	21	-235,399		21,176	SiO_2	165,8
	22	-145,234		4,213	HE	175,6
55	23	- 1890,770		49,919	CAF_2	219,4
	24	-156,092		0,678	HE	224,3
	25	340,445		66,046	SiO_2	255,5
	26	-383,246		0,680	HE	254,8
	27	137,326		49,212	CAF_2	218,0
	28	457,970	A	0,678	HE	209,9

EP 1 164 399 A2

(fortgesetzt)

	Fläche	Radius	Asphäre	Dicke	Material	Durchm.
5	29	147,683		15,743	SIO2	181,5
	30	120,693		37,797	HE	159,6
	31	-420,368		6,329	SIO2	159,6
10	32	139,505		25,622	HE	140,7
	33	-378,597		6,329	SIO2	140,7
	34	167,539		39,624	HE	139,8
15	35	-112,503		8,239	SIO2	139,8
	36	504,607		18,193	HE	174,3
	37	-369,374		15,678	SIO2	174,6
20	38	-205,396		1,373	HE	181,7
	39	-		31,888	CAF2	214,3
		1692,687				
25	40	-220,732		1,536	HE	220,3
	41	1213,241		32,223	CAF2	256,7
	42	-430,691		0,692	HE	259,4
30	43	735,809		63,006	CAF2	274,9
	44	-355,045		9,223	HE	278,5
	45	∞		0,633	HE	271,7
35	AS	∞		0,000	HE	271,7
	46	1056,085		20,400	CAF2	272,1
	47	-		0,792	HE	271,5
40		5047,421				
	48	260,901		46,828	CAF2	266,8
	49	-		23,712	HE	264,5
45		1697,534				
	50	-317,482		10,850	SIO2	264,5
	51	-488,982		8,402	HE	262,0
50	52	-339,784		13,562	SIO2	262,0
	53	-295,518		0,718	HE	261,9
	54	152,565		37,779	CAF2	213,7
55	55	505,038		3,020	HE	208,6
	56	116,772		28,279	SIO2	168,9
	57	258,363		16,383	HE	160,8
55	58	-	A	10,966	SIO2	154,6
		5272,757				
	59	323,933		0,897	HE	133,4
55	60	142,873		27,124	CAF2	121,2
	61	∞		8,137	LUFT	102,4

EP 1 164 399 A2

(fortgesetzt)

5	Fläche	Radius	Asphäre	Dicke	Material	Durchm.
62	∞			18,083	CAF2	76,0
63	∞			12,000	LUFT	51,1
	Im					

10 [0066] Asphärenformel:

$$15 z = \frac{\frac{1}{R} h^2}{1 + \sqrt{1 - (1 - EX) \left(\frac{1}{R}\right)^2 h^2}} + \sum_{k=1} c_k h^{2k+2}$$

z: Pfeilhöhe; h: Höhe; R: Radius; EX: Exzentrizität; c_k : Asphärenkonstanten

20 ASPHÄRE AN FLÄCHE 3

RADIUS = -1393.13098
 EX= .0000000000
 C 1 = .4063752600E-07
 25 C 2 = .2071817000E-11
 C 3 =-.6785322600E-16
 C 4 = .1029460700E-18
 C 5 =-.2998039200E-22
 C 6 = .3527081700E-26

30

ASPHÄRE AN FLÄCHE 12

RADIUS =-16545.56046
 EX= -43143.0300000000
 C 1 =-.4810999900E-07
 35 C 2 = .4047924800E-11
 C 3 =-.8963528600E-16
 C 4 = .8505763100E-20
 C 5 =-.2882210400E-23
 40 C 6 = .5453287000E-27

ASPHÄRE AN FLÄCHE 20

45 RADIUS =-567.37264
 EX= .0000000000
 C 1 =-.3925583500E-08
 C 2 =-.1562788800E-11
 C 3 =-.1025893700E-16
 50 C 4 =-.2599978800E-20
 C 5 = .8906747700E-25
 C 6 =-.3796689800E-28

ASPHÄRE AN FLÄCHE 28

55 RADIUS = 457.96974
 EX= .0000000000
 C 1 = .6773315100E-08

EP 1 164 399 A2

C 2 =-.3998553500E-12
 C 3 =-.1364056800E-16
 C 4 =-.1474625900E-21
 C 5 =-.2509622300E-25
 C 6 = .1507291900E-29
 5

ASPHÄRE AN FLÄCHE 58

RADIUS = -5272.75688
 10 EX= .0000000000
 C 1 =-.1963426400E-07
 C 2 = .2768505300E-12
 C 3 = .1262120200E-15
 C 4 =-.1811119000E-19
 15 C 5 = .1171493900E-23
 C 6 =-.3104888900E-28

[0067] Beispiel nach Figur 6:

20 Arbeitswellenlänge 1 = 248,4nm
 Bildfeld-Durchmesser = 27,2mm
 Bildseitige numerische Apertur NA = 0,8
 Abbildungsmaßstab β = -0,25
 25 $n(\text{SiO}_2) = 1,5084$

	Fläche	Radius	Asphäre	Dicke	Material	Durchm.
	OB	∞		32,000	LUFT	
30	1	∞		4,253	LUFT	121,9
	2	-1143,702		7,789	SiO ₂	122,9
	3	366,821		11,482	LUFT	127,5
35	4	249,157		23,794	SiO ₂	138,2
	5	-289,424		0,750	LUFT	139,4
	6	329,633		18,667	SiO ₂	140,7
40	7	-444,218		0,750	LUFT	140,2
	8	268,864		16,633	SiO ₂	135,5
	9	1167,441	A	0,750	LUFT	131,9
45	10	360,081		8,628	SiO ₂	129,2
	11	118,445		21,270	LUFT	120,1
	12	-775,270		7,000	SiO ₂	119,7
50	13	156,713		23,965	LUFT	118,8
	14	-190,304		7,000	SiO ₂	119,8
	15	266,520		27,800	LUFT	131,4
	16	-141,408		7,149	SiO ₂	134,4
55	17	2327,162	A	7,878	LUFT	162,8
	18	-999,626		32,538	SiO ₂	169,4
	19	-148,399		0,750	LUFT	177,5
	20	-1179,797	A	40,792	SiO ₂	207,1

EP 1 164 399 A2

(fortgesetzt)

	Fläche	Radius	Asphäre	Dicke	Material	Durchm.
5	21	-190,467		0,750	LUFT	215,C
	22	506,448		42,194	SIO2	236,C
	23	-318,978		0,750	LUFT	236,6
10	24	156,565		61,867	SIO2	220,3
	25	-1909,591	A	0,750	LUFT	209,4
	26	305,588		22,962	SIO2	186,3
15	27	178,412		27,808	LUFT	157,7
	28	-441,206		7,000	SIO2	154,8
	29	141,453		34,534	LUFT	138,2
20	30	-176,778		7,000	SIO2	137,5
	31	204,086		40,524	LUFT	141,8
	32	-114,660		7,000	SIO2	143,5
25	33	1254,417		16,848	LUFT	176,1
	34	-386,520		31,318	SIO2	181,6
	35	-187,128		0,750	LUFT	198,8
30	36	-7551,297		32,372	SIO2	235,1
	37	-271,610		0,750	LUFT	239,3
	38	985,139		48,181	SIO2	264,8
35	39	-280,307		0,750	LUFT	266,7
	40	485,845		42,861	SIO2	265,0
	41	-19641,172		0,750	LUFT	260,C
40	42	∞		0,750	LUFT	259,6
	AS	∞		0,000	LUFT	259,6
	43	413,812		31,899	SIO2	258,5
45	44	-1463,530		41,090	LUFT	257,1
	45	-229,000		7,000	SIO2	252,9
	46	-761,338		16,518	LUFT	258,2
50	47	-346,924		22,741	SIO2	258,3
	48	-221,418		0,750	LUFT	260,0
	49	265,978		21,446	SIO2	240,4
55	50	700,398		0,750	LUFT	238,8
	51	203,760		28,367	SIO2	224,4
	52	565,063		0,750	LUFT	219,8
55	53	124,657		33,574	SIO2	185,9
	54	255,790		3,089	LUFT	175,4
	55	192,512		17,352	SIO2	164,2
	56	490,117	A	9,135	LUFT	155,9
	57	∞		57,580	SIO2	148,9

EP 1 164 399 A2

(fortgesetzt)

Fläche	Radius	Asphäre	Dicke	Material	Durchm.
58	∞		2,600	LUFT	76,6
59	∞		8,069	SIO2	69,6
60	∞		12,000	LUFT	59,5
IM					

10

[0068] Asphärenformel:

15

$$z = \frac{\frac{1}{R} h^2}{1 + \sqrt{1 - (1 - EX) \left(\frac{1}{R}\right)^2 h^2}} + \sum_{k=1} c_k h^{2k+2}$$

20

z: Pfeilhöhe; h: Höhe; R: Radius; EX: Exzentrizität; C_k: Asphärenkonstanten

ASPHÄRE AN FLÄCHE 9

25

RADIUS = 1167.44078
 EX = -148.8088700000
 C 1 = -.3810274500E-07
 C 2 = .1825110100E-11
 C 3 = .8703118800E-16
 C 4 = -.2547944400E-19
 C 5 = .2618280200E-23
 C 6 = -.7405173000E-28

30

ASPHÄRE AN FLÄCHE 17

35

RADIUS = 2327.16189
 EX = -543.6641800000
 C 1 = .1496899300E-07
 C 2 = -.4053465300E-11
 C 3 = -.3692162500E-16
 C 4 = .1322169800E-19
 C 5 = -.7575130800E-24
 C 6 = -.1121083700E-27

ASPHÄRE AN FLÄCHE 20

45

RADIUS = -1179.79732
 EX = 88.7124390000
 C 1 = .5780601700E-08
 C 2 = .2633543200E-12
 C 3 = -.3666325900E-16
 C 4 = .7930956500E-21
 C 5 = -.7002646400E-26
 C 6 = -.4010891200E-29

50

ASPHÄRE AN FLÄCHE 25

RADIUS = -1909.59064
 EX = .0000000000

EP 1 164 399 A2

5
C 1 = .5895489200E-08
C 2 = .4254414900E-13
C 3 = -.4954342300E-18
C 4 = -.9017812800E-21
C 5 = .3307499000E-25
C 6 = -.5028285900E-30

ASPHÄRE AN FLÄCHE 56

10
RADIUS = 490.11681
EX = -4.7440051000
C 1 = .6613898200E-08
C 2 = -.9371994200E-12
C 3 = .7675398100E-16
15
C 4 = -.9919946900E-20
C 5 = .9420632400E-24
C 6 = -.4092113200E-28

20 **Patentansprüche**

1. Projektionsobjektiv, insbesondere für die Mikrolithographie, mit einer Objektebene, mit einer Bildebene, mit einer Linsenanordnung und mit wenigstens einem mit Gas gefüllten oder mit Gas durchströmten Gasraum, **dadurch gekennzeichnet, daß** der Gasraum als wenigstens annähernd planparalleler Manipulationsraum (13) ausgebildet ist, und daß durch Druckänderungen und/oder Gaszusammensetzungsänderungen im Manipulationsraum (13) die Brechzahl veränderbar ist.
2. Projektionsobjektiv, nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** sich der Manipulationsraum (13) zwischen der Linsenanordnung (4) und der Bildebene (9) befindet.
3. Projektionsobjektiv, nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** sich der Manipulationsraum (13) in der Linsenanordnung (4) befindet.
4. Projektionsobjektiv nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet, daß** der Manipulationsraum (13) zwischen einer Abschlußplatte (12) und der zu der Abschlußplatte (12) benachbart liegenden Linse (4a) angeordnet ist.
5. Projektionsobjektiv nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet, daß** eine Abschlußplatte (12) der Linsenanordnung (4) zweigeteilt ist, und daß die beiden Abschlußplattenteile (12a, 12b) auf Abstand voneinander angeordnet sind und zwischen sich den Manipulationsraum (13) bilden.
6. Projektionsobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, daß** über die Gaszusammensetzung ein Vorhalt der Brechzahl derart einstellbar ist, daß die Brechzahl in beide Richtungen manipulierbar ist.
7. Projektionsobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, daß** neben dem Manipulationsraum (13) ein weiterer wenigstens annähernd planparalleler manipulierbarer Gaszwischenraum (16) zur Be seitigung von Bildfeldwölbung auf einem zu belichtenden Substrat (11) in der sechsten optischen Gruppe (LG6) vorgesehen ist.
8. Projektionsobjektiv, insbesondere für die Mikrolithographie mit einer Linsenanordnung, bestehend aus
50 einer ersten Linsengruppe (LG1) positiver Brechkraft,
einer zweiten Linsengruppe (LG2) negativer Brechkraft,
einer dritten Linsengruppe (LG3) positiver Brechkraft,
einer vierten Linsengruppe (LG4) negativer Brechkraft,
55 einer fünften Linsengruppe (LG5) positiver Brechkraft und
einer sechsten optischen Gruppe (LG6),

dadurch gekennzeichnet, daß in der sechsten optischen Gruppe ein erstes optisches Element (12) mit Krüm-

EP 1 164 399 A2

mungsradien R1 und R2, einer Dicke d1 und einem Durchmesser DU1 vorgesehen ist wobei gilt $|R1|>3000\text{mm}$, $|R2|>3000\text{mm}$ und

$$5 \quad \frac{d1}{DU1} > \frac{1}{5}$$

9. Projektionsobjektiv, nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**, daß gilt $|R1|>5000\text{mm}$ und $|R2|>5000\text{mm}$

10. Projektionsobjektiv, nach Anspruch 8 oder 9, **dadurch gekennzeichnet**, daß gilt

$$10 \quad \frac{d1}{DU1} > \frac{1}{4} \text{ vorzugsweise } \frac{d1}{DU1} > \frac{1}{3}$$

15. 11. Projektionsobjektiv nach Anspruch 8, 9 oder 10, **dadurch gekennzeichnet**, daß das erste optische Element (12) und ein zweites optisches Element (12a,4a) der sechsten optischen Gruppe einen Gasraum (13) einschließen, wobei für den Krümmungsradius R3 der Fläche des zweiten optischen Elementes (12a,4a), die der ersten Linse (12) zugewandt ist, gilt: $|R3|>3000\text{mm}$

20. 12. Projektionsobjektiv nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet**, daß für den Krümmungsradius R3 gilt: $|R3|>5000\text{mm}$

13. Projektionsobjektiv nach Anspruch 11 oder 12, **dadurch gekennzeichnet**, daß für den Krümmungsradius R4 der weiteren Fläche des zweiten optischen Elementes (12a,4a) gilt: $|R4|>3000\text{mm}$, vorzugsweise $|R4|>5000\text{mm}$

25. 14. Projektionsobjektiv nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet**, daß das zweite optische Element (12a,4a) eine Dicke d2 aufweist, wobei gilt: $d1+d2>60,0\text{mm}$

30. 15. Projektionsobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 15, **dadurch gekennzeichnet**, daß in der ersten Linsengruppe (LG1) eine Linse (4c) mit einer asphärischen Fläche vorgesehen ist.

35. 16. Projektionsobjektiv nach Anspruch 15, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Linse (4c) mit der asphärischen Fläche in Lichtrichtung vor dem ersten Bauch angeordnet ist.

17. Projektionsobjektiv nach Anspruch 15 oder 16, **dadurch gekennzeichnet**, daß die asphärische Fläche auf der ersten gekrümmten Fläche einer Linse (4c) angeordnet ist.

40. 18. Projektionsobjektiv nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Projektionsobjektiv (3) bildseitig eine numerische Apertur von mindestens 0,75, vorzugsweise 0,85, aufweist.

45. 19. Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithographie mit einer Lichtquelle, die Strahlung von kürzerer Wellenlänge als 370 nm abgibt, **dadurch gekennzeichnet**, daß sie ein Projektionsobjektiv (3) nach zumindest einem der vorangegangenen Ansprüche umfaßt.

20. Verfahren zur Herstellung mikrostrukturierter Bauteile, bei dem ein mit einer lichtempfindlichen Schicht versehenes Substrat mittels einer Maske und einer Projektionsbelichtungsanlage mit einer Linsenanordnung durch UV-Licht belichtet wird, **dadurch gekennzeichnet**, daß in der Projektionsbelichtungsanlage (3) ein wenigstens annähernd planparalleler Manipulationsraum (13) geschaffen wird, der mit einer Gasquelle (15) verbunden wird, wobei durch Druckänderungen und/oder Gaszusammensetzungsänderungen die Brechkraft manipuliert wird.

50. 21. Verfahren nach Anspruch 20, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Manipulationsraum (13) in dem Projektionsobjektiv eingangsseitig bzw. auf der Seite der Maske (7) eingerichtet wird.

22. Verfahren nach Anspruch 20, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Manipulationsraum 13 ausgangsseitig auf der Seite des Wafers (11) eingerichtet wird.

55. 23. Verfahren nach Anspruch 20, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Manipulationsraum (13) zwischen der Linsenanordnung (4) und der Bildebene (9) eingerichtet wird.

EP 1 164 399 A2

24. Verfahren nach Anspruch 20, **dadurch gekennzeichnet, daß** der planparallele Manipulationsraum (13) gegenüber der Umgebung abgedichtet wird, und daß ein Gasgemisch gesteuert über einen Druckanschluß (14) zu dem Manipulationsraum (13) geführt wird.
- 5 25. Verfahren nach Anspruch 20 und 24, **dadurch gekennzeichnet, daß** bei der Abstimmung des Projektionsobjektives (3) ein Füllgas eingebracht wird, das anschließend beim Betreiber durch ein Gasgemisch ausgetauscht wird.
- 10 26. Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 24, **dadurch gekennzeichnet, daß** neben dem Manipulationsraum (13) ein weiterer manipulierbarer Gaszwischenraum (16) vorgesehen wird, durch welchen eine Bildfeldwölbung auf dem zu belichtenden Substrat (11) beseitigt werden kann.
- 15 27. Verfahren zur Herstellung mikrostrukturierter Bauteile, bei dem ein mit einer lichtempfindlichen Schicht versehenes Substrat (11) mittels einer Maske (7) und einer Projektionsbelichtungsanlage (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 19 durch ultraviolettes Licht belichtet wird und gegebenenfalls nach Entwickeln der lichtempfindlichen Schicht entsprechend einem auf der Maske (11) enthaltenen Muster strukturiert wird.

20

25

30

35

40

45

50

55

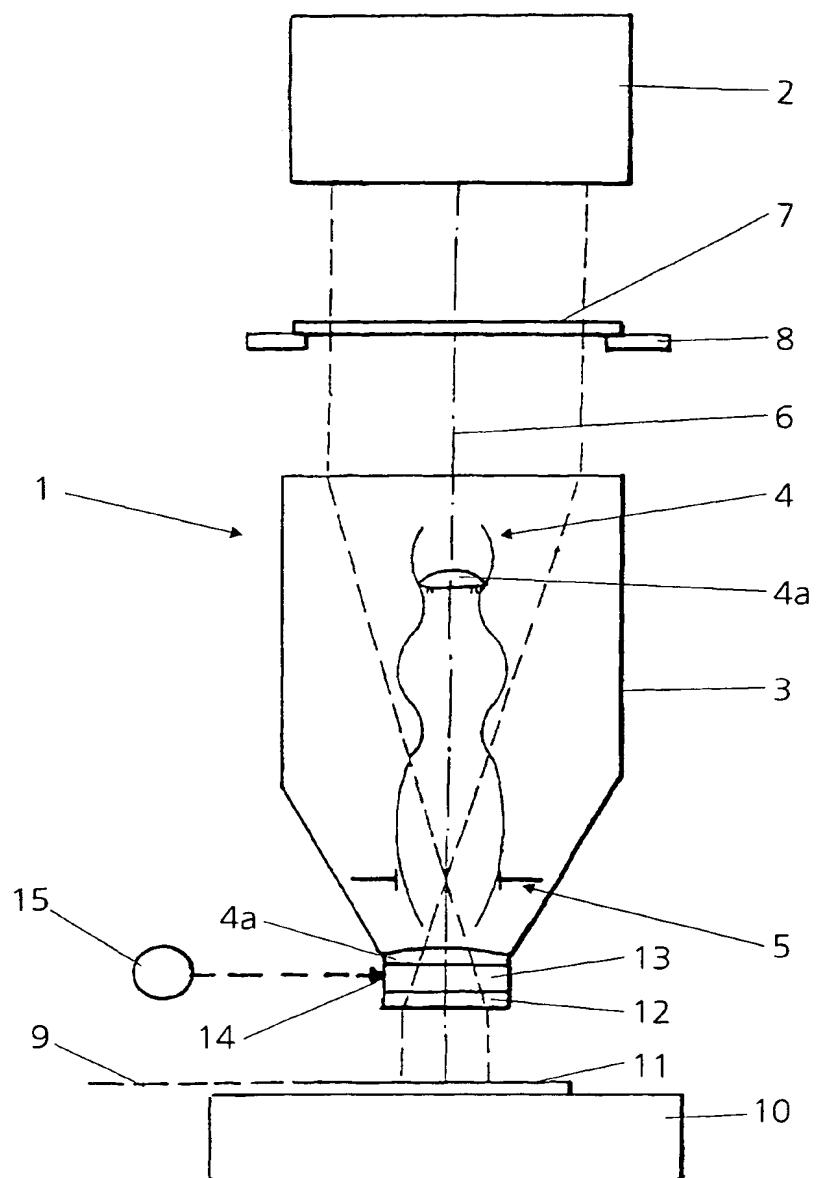


Fig. 1

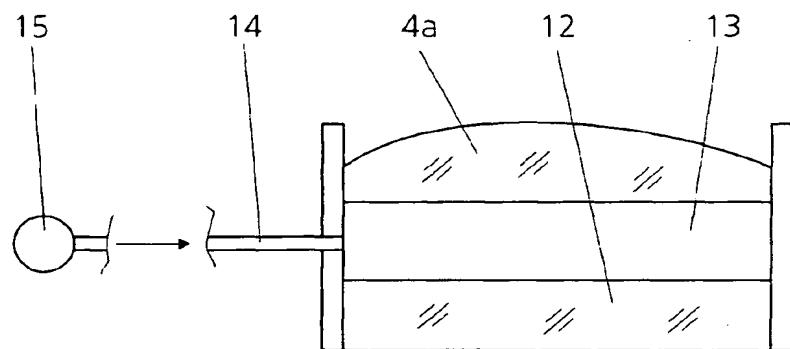


Fig. 2

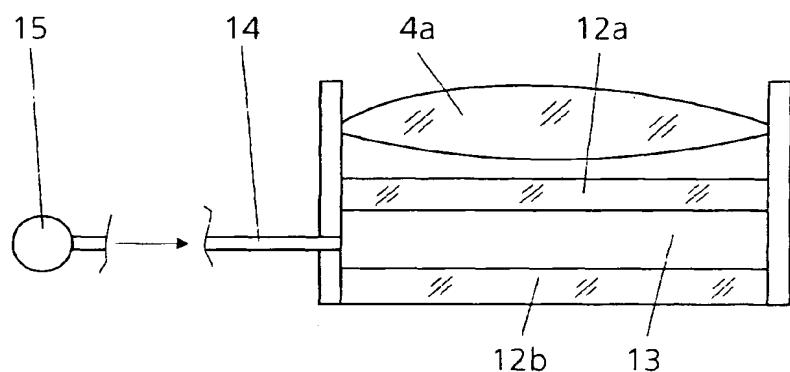


Fig. 3

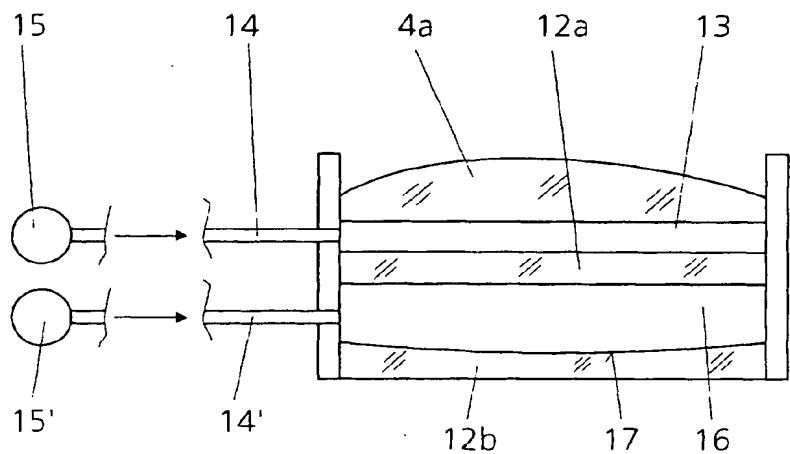


Fig. 4

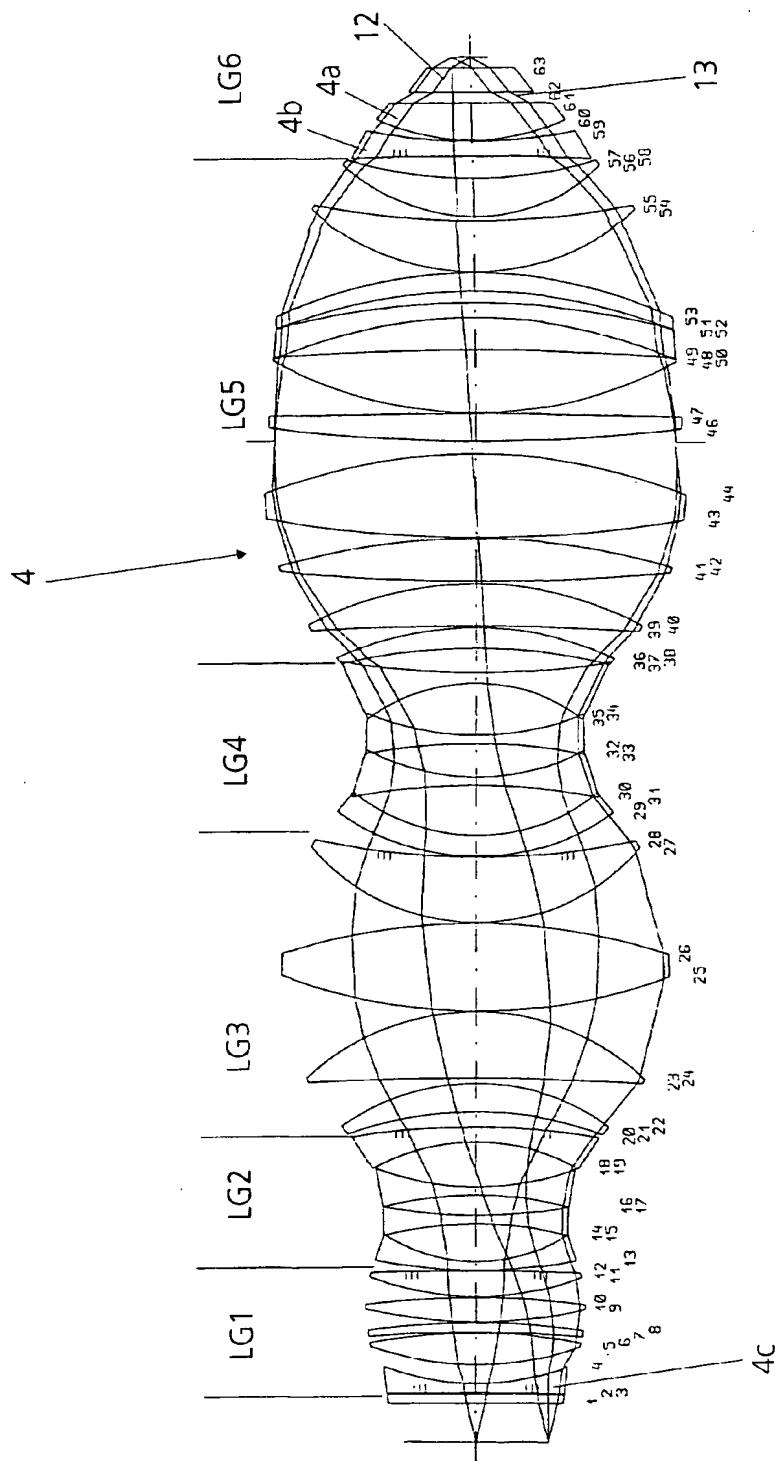


Fig. 5

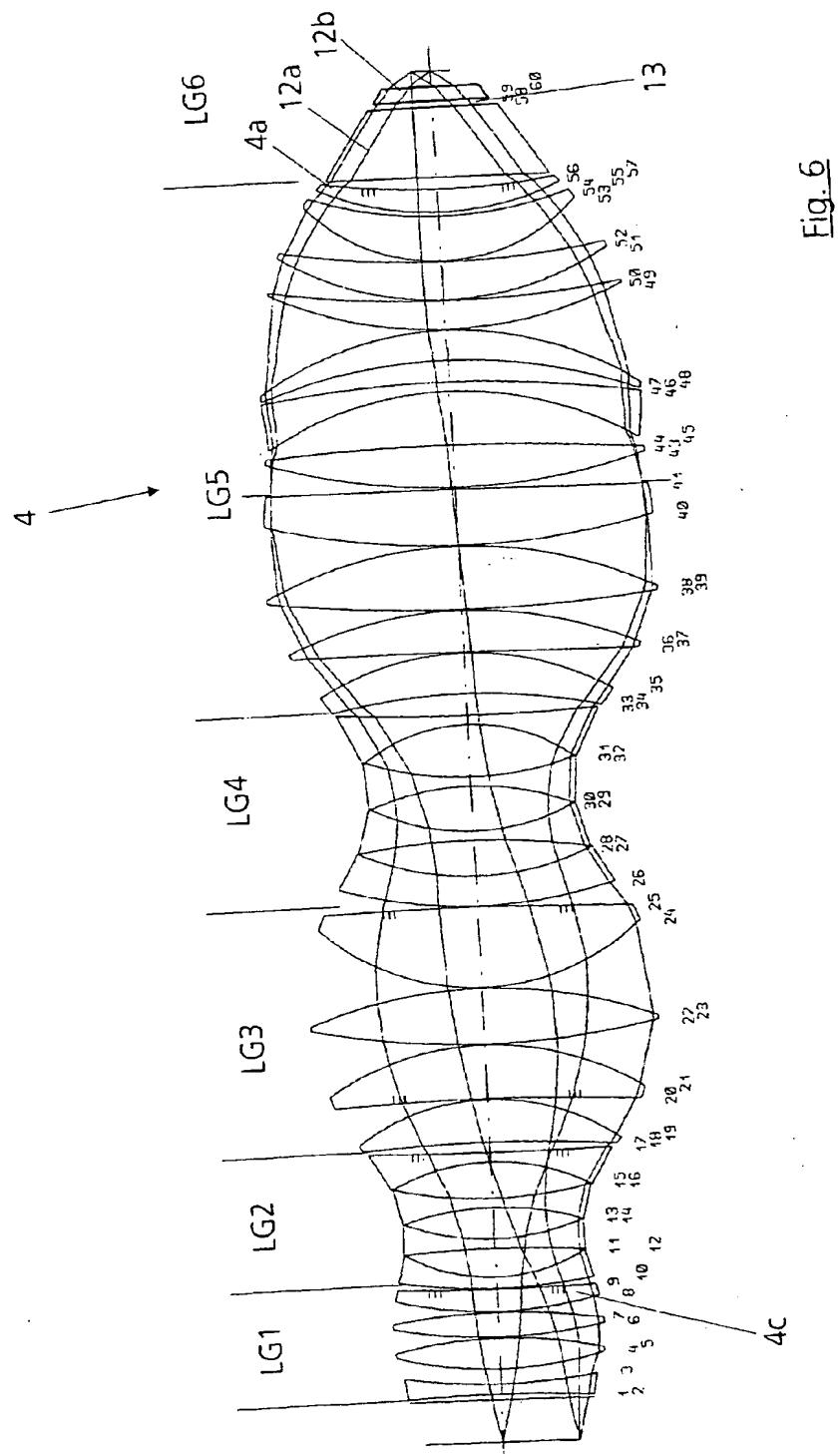


Fig. 6